

Публикации по теме диссертации официального оппонента М.В. Дорохина

1. Яковлев Г.Е., Дорохин М.В., Зубков В.И. и др. Особенности электрохимического вольт-фарадного профилирования арсенид-галлиевых светоизлучающих и рНЕМТ-структур с квантово-размерными областями //Физика и техника полупроводников. – 2018. – Т. 52. – №. 8. – С. 873-880.
2. Малышева Е.И., Дорохин М.В., Данилов Ю.А. и др. Повышение рабочей температуры спиновых светоизлучающих диодов (Ga,Mn)As/GaAs путем постростовых воздействий //Физика твердого тела. – 2018. – Т. 60. – №. 11. – С. 2141-2146.
3. Ерофеева И.В., Дорохин М.В., Лесников В.П. и др. Термоэлектрические эффекты в наноразмерных слоях силицида марганца //Физика и техника полупроводников. – 2017. – Т. 51. – №. 11. – С. 1456-1461.
4. Малышева Е.И., Дорохин М.В., Здоровейщев А.В. и др. Туннелирование и инжекция в ферромагнитных структурах InGaAs/GaAs/(Ga, Mn) As и InGaAs/n+-GaAs/(Ga, Mn) As //Физика твердого тела. – 2016. – Т. 58. – №. 11. – С. 2190-2194.
5. Bobrov A. I., Danilov Yu. A., Dorokhin M. V. et al. Application of cobalt in spin light-emitting Schottky diodes with InGaAs/GaAs quantum wells // Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques.— 2015.— jul.— Т. 9, no. 4.— P. 706–709.
6. Dorokhin M. V., Danilov Yu. A., Zvonkov B. N. et al. The circular polarization inversion in δ <Mn>/InGaAs/GaAs light-emitting diodes // Applied Physics Letters.— 2015.—jul.— Т. 107, no. 4.— P. 042406.
7. Здоровейщев А.В., Дорохин М.В., Демина П.Б. и др. Ферромагнитный инжектор CoPt в светоизлучающих диодах Шоттки на основе наноразмерных структур InGaAs/GaAs //Физика и техника полупроводников. – 2015. – Т. 49. – №. 12. – С. 1649-1653.
8. Малышева Е.И., Дорохин М.В., Ведь М.В. и др. Циркулярно-поляризованная электролюминесценция светоизлучающих диодов InGaAs/GaAs/(AIII,Mn)BV на основе структур с туннельным барьером //Физика и техника полупроводников. – 2015. – Т. 49. – №. 11. – С. 1497-1500.
9. Дорохин М. В. и др. Эпитаксиальное выращивание слоев MnGa/GaAs для диодов со спиновой инжекцией //Физика твердого тела. – 2014. – Т. 56. – №. 10. – С. 2062-2065.